



изд. 11
+

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 15133—77
(СТ СЭВ 2767—85)**

Издание официальное

Цена 15 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Термины и определения

Semiconductor devices. Terms and definitions

ГОСТ

15133—77*

(СТ СЭВ 2767—85)

Взамен
ГОСТ 15133—69

ОКСТУ 6201

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 апреля 1977 г. № 1061 срок введения установлен

с 01.07.78

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения полупроводниковых приборов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2767—85, за исключением терминов, указанных в справочном приложении.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, когда исключена возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, недопустимые синонимы — курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (январь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне 1980 г., июне 1982 г.; Пост. № 2544 от 28.06.82, октябре 1986 г. (ИУС 9—80, 10—82, 1—87).

© Издательство стандартов, 1987

Термины	Определение
Физические элементы полупроводниковых приборов	
<p>1. Электрический переход Переход D. Elektrischer Übergang (Sperrschicht) E. Junction F. Junction</p>	<p>Переходный слой в полупроводнике материале между двумя областями с различными типами электропроводности или разными значениями удельной электрической проводимости.</p> <p>Примечание. Одна из областей может быть металлом</p>
<p>2. Электронно-дырочный переход p-n переход D. pn-Übergang E. P-N junction F. Junction P-N</p>	<p>Электрический переход между двумя областями полупроводника, одна из которых имеет электропроводность n-типа, а другая p-типа</p>
<p>3. Электронно-электронный переход n-n^+ переход D. nn⁺-Übergang E. N-N⁺ junction F. Junction N-N⁺</p>	<p>Электрический переход между двумя областями полупроводника n-типа, обладающими различными значениями удельной электрической проводимости</p>
<p>4. Дырочно-дырочный переход p-p^+ переход D. pp⁺-Übergang E. P-P⁺ junction F. Junction P-P⁺</p>	<p>Электрический переход между двумя областями полупроводника p-типа, обладающими различными значениями удельной электрической проводимости</p> <p>Примечание. В терминах 3 и 4 «+» условно обозначает область с более высокой удельной электрической проводимостью</p>
<p>5. Резкий переход D. Steiler Übergang E. Abrupt junction F. Junction abrupte</p>	<p>Электрический переход, в котором толщина области изменения концентрации примеси значительно меньше толщины области пространственного заряда.</p> <p>Примечание. Под толщиной области понимают ее размер в направлении градиента концентрации примеси</p>
<p>6. Плавный переход D. Stetiger Übergang E. Graded junction F. Junction graduelle</p>	<p>Электрический переход, в котором толщина области изменения концентрации примеси сравнима с толщиной области пространственного заряда</p>
<p>7. Плоскостной переход D. Flächenübergang E. Surface junction F. Junction de par surface</p>	<p>Электрический переход, у которого линейные размеры, определяющие его площадь, значительно больше толщины</p>
<p>8. Точечный переход D. Punktübergang E. Point-contact junction F. Junction à pointe</p>	<p>Электрический переход, все размеры которого меньше характеристической длины, определяющей физические процессы в переходе и в окружающих его областях.</p>

Термин	Определение
9. Диффузионный переход D. Diffundierter Übergang E. Diffused junction F. Jonction à diffusion	<p>Примечание. Характеристической длиной может быть толщина области пространственного заряда, диффузионная длина и т. д.</p> <p>Электрический переход, полученный в результате диффузии атомов примеси в полупроводнике</p>
10. Планарный переход D. Planarübergang E. Planar junction F. Jonction planar	<p>Диффузионный переход, образованный в результате диффузии примеси сквозь отверстие в защитном слое, нанесенном на поверхность полупроводника</p>
11. Конверсионный переход D. Konversionsübergang E. Conversion junction F. Jonction de conversion	<p>Электрический переход, образованный в результате конверсии полупроводника, вызванной обратной диффузией примеси в соседнюю область, или активацией атомов примеси</p>
12. Сплавной переход Ндп. <i>Влававной переход</i> D. Legierter Übergang E. Alloyed junction F. Jonction allié	<p>Электрический переход, образованный в результате сплавления в полупроводник и последующей рекристаллизации металла или сплава, содержащего донорные и (или) акцепторные примеси</p>
13. Микросплавной переход Ндп. <i>Микровлававной переход</i> D. Mikrolegierter Übergang E. Micro-alloy junction F. Jonction microallié	<p>Сплавной переход, образованный в результате сплавления на малую глубину слоя металла или сплава, предварительно нанесенного на поверхность полупроводника</p>
14. Выращенный переход Ндп. <i>Тяннутый переход</i> D. Gezogener Übergang E. Grown junction F. Jonction de croissance	<p>Электрический переход, образованный при выращивании полупроводника из расплава</p>
15. Эпитаксиальный переход D. Epitaxieübergang E. Epitaxial junction F. Jonction épitaxiale	<p>Электрический переход, образованный эпитаксиальным наращиванием.</p> <p>Примечание. Эпитаксиальное наращивание — создание на монокристаллической подложке слоя полупроводника, сохраняющего кристаллическую структуру подложки</p>
16. Гетерогенный переход Гетеропереход D. Heteroübergang E. Heterogenous junction F. Jonction hétérogène	<p>Электрический переход, образованный в результате контакта полупроводников с различной шириной запрещенной зоны</p>
17. Гомогенный переход Гомопереход D. Homogener Übergang E. Homogenous junction F. Jonction homogène	<p>Электрический переход, образованный в результате контакта полупроводников с одинаковой шириной запрещенной зоны</p>
18. Переход Шоттки D. Schottky-Übergang E. Schottky junction F. Jonction Schottky	<p>Электрический переход, образованный в результате контакта между металлом и полупроводником</p>

Термин	Определение
19. Выпрямляющий переход D. Gleichrichterübergang E. Rectifying junction F. Jonction redresseuse	Электрический переход, электрическое сопротивление которого при одном направлении тока больше, чем при другом
20. Омический переход Ндп. <i>Линейный контакт</i> D. Ohmischer Übergang E. Ohmic junction F. Jonction ohmique	Электрический переход, электрическое сопротивление которого не зависит от направления тока в заданном диапазоне значений токов
21. Эмиттерный переход D. Emitterübergang E. Emitter junction F. Jonction émetteur	Электрический переход между эмиттерной (27)* и базовой (26) областями полупроводникового прибора (62)
22. Коллекторный переход D. Kollektorübergang E. Collector junction F. Jonction collecteur	Электрический переход между базовой (26) и коллекторной (28) областями полупроводникового прибора (62)
23. Дырочная область p-область D. Defektelektronengebiet E. P-region F. Région P	Область в полупроводнике с преобладающей дырочной электропроводностью
24. Электронная область n-область D. Elektronengebiet E. N-region F. Région N	Область в полупроводнике с преобладающей электронной электропроводностью
25. Область собственной электропроводности i-область Ндп. <i>Собственная область</i> D. Eigenleitungsgebiet E. Intrinsic region F. Région intrinsèque	Область в полупроводнике, обладающая свойствами собственного полупроводника
26. Базовая область База D. Basisgebiet E. Base region F. Région de base	Область полупроводникового прибора (62), в которую инжектируются неосновные для этой области носители заряда
27. Эмиттерная область Эмиттер D. Emittergebiet E. Emitter region F. Région d'émetteur	Область полупроводникового прибора (62), назначением которой является инжекция носителей заряда в базовую область
28. Коллекторная область Коллектор D. Kollektorgebiet E. Collector region F. Région de collecteur	Область полупроводникового прибора (62), назначением которой является экстракция носителей из базовой области

* Числа в скобках обозначают порядковый номер терминов, помещенных в настоящем стандарте.

Термин	Определение
<p>29. Активная часть базовой области</p> <p>D. Aktiver Teil des Basisgebietes eines bipolaren Transistors E. Active part of base region F. Région active de base</p>	<p>Часть базовой области биполярного транзистора, в которой накопление или рассасывание неосновных носителей заряда происходит за время перемещения их от эмиттерного перехода к коллекторному переходу</p>
<p>30. Пассивная часть базовой области</p> <p>D. Passiver Teil des Basisgebietes eines bipolaren Transistors E. Passive part of base region F. Région passive de base</p>	<p>Часть базовой области биполярного транзистора, в которой для накопления или рассасывания неосновных носителей заряда необходимо время большее, чем время их перемещения от эмиттерного перехода к коллекторному переходу</p>
<p>31. Проводящий канал</p> <p>D. Kanal E. Channel F. Canal</p>	<p>Область полевого транзистора, в которой регулируется поток носителей заряда.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Данное понятие не следует смешивать с «каналом утечки», возникающим в месте выхода p-n перехода на поверхность кристалла.</p> <p>2. Проводящий канал может быть n или p-типа в зависимости от типа электропроводности полупроводника</p>
<p>32. Исток</p> <p>D. Source (Quelle) E. Source F. Source</p>	<p>Электрод полевого транзистора (100), через который в проводящий канал втекают носители заряда</p>
<p>33. Сток</p> <p>D. Drain (Senke) E. Drain F. Drain</p>	<p>Электрод полевого транзистора (100), через который из проводящего канала вытекают носители заряда</p>
<p>34. Затвор</p> <p>D. Gate (Tor) E. Gate F. Grille</p>	<p>Электрод полевого транзистора (100), на который подается электрический сигнал</p>
<p>35. Структура полупроводникового прибора</p> <p>Структура</p> <p>D. Struktur eines Halbleiterbauelementes E. Structure F. Structure</p>	<p>Последовательность граничащих друг с другом областей полупроводника, различных по типу электропроводности или по значению удельной проводимости, обеспечивающая выполнение полупроводниковым прибором (62) его функций.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Примеры структур полупроводниковых приборов: p-n; p-n-p; p-i-n; p-n-p-n и др.</p> <p>2. В качестве областей могут быть использованы металл и диэлектрик</p>

Термин	Определение
<p>36. Структура металл—диэлектрик—полупроводник Структура МДП D. Metall-Dielektrikum-Halbleiter-Struktur (MIS-Struktur) E. MIS-structure F. Structure-MIS</p>	<p>Структура, состоящая из последовательного сочетания металла, диэлектрика и полупроводника</p>
<p>37. Структура—металл—оксид—полупроводник Структура МОП D. Metall-Oxid-Halbleiter-Struktur (MOS-Struktur) E. MOS-structure F. Structure-MOS</p>	<p>Структура, состоящая из последовательного сочетания металла, оксида на поверхности полупроводника и полупроводника</p>
<p>38. Мезаструктура D. Mesastruktur E. Mesa-structure F. Structure-mesa</p>	<p>Структура, имеющая форму выступа, образованного удалением периферийных участков кристалла полупроводника либо наращиванием</p>
<p>39. Обедненный слой D. Verarmungsschicht E. Depletion layer F. Couche de déplétion</p>	<p>Слой полупроводника, в котором концентрация основных носителей заряда меньше разности концентрации ионизованных доноров и акцепторов</p>
<p>40. Запирающий слой Ндп: Запорный слой D. Sperrschicht E. Barrier region (layer) F. Région de barrière</p>	<p>Обедненный слой между двумя областями полупроводника с различными типами электропроводности или между полупроводником и металлом</p>
<p>41. Обогащенный слой D. Anreicherungs-schicht E. Enriched layer F. Couche enrichie</p>	<p>Слой полупроводника, в котором концентрация основных носителей заряда больше разности концентрации ионизованных доноров и акцепторов</p>
<p>42. Инверсный слой D. Inversionsschicht E. Inversion layer F. Couche d'inversion</p>	<p>Слой у поверхности полупроводника, в котором тип электропроводности отличается от типа электропроводности в объеме полупроводника в связи с наличием электрического поля поверхностных состояний, внешнего электрического поля у поверхности или поля контактов разности потенциалов</p>

Явления в полупроводниковых приборах

<p>43. Прямое направление для $p-n$ перехода D. Durchlassrichtung des $p-n$-Überganges E. Forward direction (of a P-N junction) F. Sens direct (d'une jonction P-N)</p>	<p>Направление постоянного тока, в котором $p-n$ переход имеет наименьшее сопротивление</p>
---	--

Термин	Определение
<p>44. Обратное направление для р-п перехода</p> <p>D. Sperrichtung des pn-Überganges</p> <p>E. Reverse direction (of a P-N junction)</p> <p>F. Sens inverse (d'une jonction P-N)</p>	<p>Направление постоянного тока, в котором р-п переход имеет наибольшее сопротивление</p>
<p>45. Пробой р-п перехода</p> <p>D. Durchbruch des pn-Überganges</p> <p>E. Breakdown of a P-N junction</p> <p>F. Claquage (d'une jonction P-N)</p>	<p>Явление резкого увеличения дифференциальной проводимости р-п перехода при достижении обратным напряжением (током) критического для данного прибора значения.</p> <p>Примечание. Необратимые изменения в переходе не являются необходимым следствием пробоя</p>
<p>46. Электрический пробой р-п перехода</p> <p>D. Elektrischer Durchbruch des pn-Überganges</p> <p>E. P-N junction electrical breakdown</p> <p>F. Claquage électrique (d'une jonction P-N)</p>	<p>Пробой р-п перехода, обусловленный лавинным размножением носителей заряда или туннельным эффектом под действием приложенного напряжения</p>
<p>47. Лавинный пробой р-п перехода</p> <p>D. Lawinendurchbruch des pn-Überganges</p> <p>E. (P-N junction) avalanche breakdown</p> <p>F. Claquage par avalanche (d'une jonction P-N)</p>	<p>Электрический пробой р-п перехода, вызванный лавинным размножением носителей заряда под действием сильного электрического поля</p>
<p>48. Туннельный пробой р-п перехода</p> <p>D. Tunneldurchbruch des pn-Überganges</p> <p>E. Zenner (tunnel) breakdown</p> <p>F. Claquage par effet Zenner (tunnel)</p>	<p>Электрический пробой р-п перехода, вызванный туннельным эффектом</p>
<p>49. Тепловой пробой р-п перехода</p> <p>D. Thermischer Durchbruch des pn-Überganges</p> <p>E. (P-N junction) thermal breakdown</p> <p>F. Claquage par effet thermique (d'une jonction P-N)</p>	<p>Пробой р-п перехода, вызванный ростом числа носителей заряда в результате нарушения равновесия между выделяемыми в р-п переходе и отводимым от него теплом</p>
<p>50. Модуляция толщины базы</p> <p>D. Modulation der Basisbreite</p> <p>E. Base thickness modulation</p> <p>F. Modulation d'épaisseur de base</p>	<p>Изменение толщины базовой области, вызванное изменением толщины запирающего слоя при изменении значения обратного напряжения, приложенного к коллекторному переходу</p>

Термин	Определение
<p>51. Эффект смыкания Ндп. Прокол базы D. Durchgreiffeffekt E. Punch-through F. Pénétration</p>	<p>Смыкание обедненного слоя коллекторного перехода в результате его расширения на всю толщину базовой области с обедненным слоем эмиттерного перехода</p>
<p>52. Накопление неравновесных носителей заряда в базе Накопление заряда в базе D. Speicherung von Überschussladungsträgern in der Basis. E. Minority carrier storage (in the base) F. Accumation de porteurs d'excès dans la base</p>	<p>Увеличение концентрации и величины зарядов, образованных неравновесными носителями заряда в базе в результате увеличения инжекции или в результате генерации носителей заряда</p>
<p>53. Рассасывание неравновесных носителей заряда в базе Рассасывание заряда в базе D. Abbau von Überschussladungsträgern in der Basis E. Excess carrier resorption (in the base) F. Résorption de porteurs d'excès dans la base</p>	<p>Уменьшение концентрации и величины зарядов, образованных неравновесными носителями заряда в базе в результате уменьшения инжекции или в результате рекомбинации</p>
<p>54. Прямое восстановление полупроводникового диода D. Einschwingen des Durchlasswiderstandes einer Halbleiterdiode E. Forward recovery F. Recouvrement direct</p>	<p>Переходный процесс, в течение которого прямое сопротивление перехода полупроводникового диода устанавливается до постоянного значения после быстрого включения перехода в прямом направлении.</p> <p>Примечание. Под словом «быстрый» в определениях 54 и 55 понимается изменение тока или напряжения за время, сравнимое или меньшее постоянной времени переходного процесса установления или восстановления сопротивления</p>
<p>55. Обратное восстановление полупроводникового диода D. Wiederherstellung des Sperrwiderstandes einer Halbleiterdiode E. Reverse recovery F. Recouvrement inverse</p>	<p>Переходный процесс, в течение которого обратное сопротивление перехода полупроводникового диода устанавливается до постоянного значения после быстрого переключения перехода с прямого направления на обратное</p>
<p>56. Закрытое состояние тиристора D. Blockierzustand eines Thyristors E. Off-state of a thyristor F. Etat bloqué de thyristor</p>	<p>Состояние тиристора (105), соответствующее участку прямой ветви вольт-амперной характеристики между нулевой точкой и точкой переключения</p>

Термин	Определение
57. Открытое состояние тиристора D. Durchlasszustand eines Thyristors E. On-state of a thyristor F. Etat passant de thyristor	Состояние тиристора (105), соответствующее низковольтному и высоковольтному участку прямой ветви вольтамперной характеристики
58. Непроводящее состояние тиристора в обратном направлении D. Sperrzustand eines Thyristors E. Reverse blocking state of a thyristor F. Etat bloqué dans le sens inverse de thyristor	Состояние тиристора (105), соответствующее участку вольтамперной характеристики при обратных токах, по значению меньших тока при обратном напряжении пробоя
59. Переключение тиристора D. Umschalten eines Thyristors E. Switching of a thyristor F. Commutation de thyristor	Переход тиристора (105) из закрытого состояния в открытое при отсутствии тока управления на управляющем выводе
60. Включение тиристора D. Zünden eines Thyristors E. Gate triggering of a thyristor F. Amorcage de thyristor	Переход тиристора (105) из закрытого состояния в открытое при подаче тока управления
61. Выключение тиристора D. Ausschalten eines Thyristors E. Gate turning-off of a thyristor F. Désamorcage de thyristor	Переход тиристора (105) из открытого состояния в закрытое при приложении обратного напряжения, уменьшенного прямого тока или при подаче тока управления

Виды полупроводниковых приборов

62. Полупроводниковый прибор (ПП) D. Halbleiterbauelement E. Semiconductor device F. Dispositif à semiconducteurs	Прибор, действие которого основано на использовании свойств полупроводника
63. Силовой полупроводниковый прибор (СПП) D. Halbleiterleistungsbauelement E. Semiconductor power device F. Diode à semiconducteur pour forte puissance	Полупроводниковый прибор, предназначенный для применения в силовых цепях электротехнических устройств
64. Полупроводниковый блок E. Semiconductor assembly F. Assemblage à semiconducteurs	Совокупность полупроводниковых приборов, соединенных по определенной электрической схеме и собранных в единую конструкцию, имеющую более двух выводов
65. Набор полупроводниковых приборов E. Semiconductor assembly set	Совокупность полупроводниковых приборов, собранных в единую конструкцию, не соединенных электрически или соединенных по одноименным выводам

Термин	Определение
<p>66. Полупроводниковый диод Диод Нал. <i>Полупроводниковый вентиль</i> D. Halbleiterdiode E. Semiconductor diode F. Diode à semiconducteurs</p>	<p>Полупроводниковый прибор с двумя выводами и несимметричной вольт-амперной характеристикой. Примечание. Если не указано особо, этим термином обозначают приборы с вольт-амперной характеристикой, типичной для единичного перехода</p>
<p>67. Точечный диод Нал. <i>Точечно-контактный диод</i> D. Halbleiterapitzendiode E. Point contact diode F. Diode à pointe</p>	<p>Полупроводниковый диод с точечным переходом</p>
<p>68. Плоскостной диод D. Halbleiterflächendiode E. Junction diode F. Diode à jonction</p>	<p>Полупроводниковый диод с плоскостным переходом</p>
<p>69. Выпрямительный полупроводниковый диод Выпрямительный диод D. Halbleitergleichrichterdiode E. Semiconductor rectifier diode F. Diode de redressement</p>	<p>Полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока, включая монтажные и охлаждающие устройства, если он образует с ними одно целое</p>
<p>69а. Лавинный выпрямительный диод E. Avalanche rectifier diode</p>	<p>Выпрямительный полупроводниковый диод с заданными характеристиками минимального напряжения пробоя, предназначенный для рассеивания в течение ограниченной длительности импульса мощности в области пробоя вольт-амперной характеристики</p>
<p>69б. Выпрямительный полупроводниковый диод с контролируемым лавинным пробоем E. Controlled-avalanche rectifier diode</p>	<p>Выпрямительный полупроводниковый диод с заданными характеристиками максимального и минимального напряжения пробоя, предназначенный для работы в установившемся режиме в области пробоя обратной ветви вольт-амперной характеристики</p>
<p>70. Выпрямительный полупроводниковый столб Выпрямительный столб E. Semiconductor rectifier stack F. Bloc de redressement (à semiconducteurs)</p>	<p>Совокупность выпрямительных полупроводниковых диодов, соединенных последовательно и собранных в единую конструкцию, имеющую два вывода</p>
<p>71. Выпрямительный полупроводниковый блок Выпрямительный блок E. Semiconductor rectifier assembly F. Assemblage de redressement (à semiconducteurs)</p>	<p>Полупроводниковый блок, собранный из выпрямительных полупроводниковых диодов</p>

Термин	Определение
<p>72. Импульсный полупроводниковый диод</p> <p>Импульсный диод</p> <p>D. Halbleiterimpulsdiode</p> <p>E. Signal diode</p> <p>F. Diode d'impulsion</p>	<p>Полупроводниковый диод, имеющий малую длительность переходных процессов в импульсных режимах работы</p>
<p>73. Диод с накоплением заряда</p> <p>E. Snap-off (step-recovery) diode</p>	<p>Импульсный полупроводниковый диод, накапливающий заряд при протекании прямого тока и обладающий эффектом резкого обратного восстановления при подаче обратного напряжения, который используется для формирования импульсов с малым временем нарастания</p>
<p>74. Туннельный диод</p> <p>D. Halbleitertunneldiode</p> <p>E. Tunnel diode</p> <p>F. Diode tunnel</p>	<p>Полупроводниковый диод на основе вырожденного полупроводника, в котором туннельный эффект приводит к появлению на вольтамперной характеристике при прямом направлении участка отрицательной дифференциальной проводимости</p>
<p>75. Обращенный диод</p> <p>D. Halbleiterunitunneldiode</p> <p>E. Unitunnel (backward) diode</p> <p>F. Diode inverse</p>	<p>Полупроводниковый диод на основе полупроводника с критической концентрацией примеси, в котором проводимость при обратном напряжении вследствие туннельного эффекта значительно больше, чем при прямом напряжении, а пиковый ток и ток впадины приблизительно равны</p>
<p>76. Сверхвысокочастотный полупроводниковый диод</p> <p>СВЧ-диод</p> <p>D. UHF-Halbleiterdiode</p> <p>E. Microwave diode</p> <p>F. Diode en hyperfréquences</p>	<p>Полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования и обработки сверхвысокочастотного сигнала</p>
<p>77. Лавинно-пролетный диод</p> <p>D. Halbleiterlawinenlaufzeitdiode</p> <p>E. Impact avalanche-(and-) transit time diode</p> <p>F. Diode à avalanche à temps de transit</p>	<p>Полупроводниковый диод, работающий в режиме лавинного размножения носителей заряда при обратном смещении электрического перехода и предназначенный для генерации сверхвысокочастотных колебаний</p>
<p>78. Инжекционно-пролетный диод</p> <p>D. Halbleiterinjektionslaufzeitdiode</p> <p>E. Injection-(and-) transit time diode</p> <p>F. Diode à injection à temps de transit</p>	<p>Полупроводниковый диод, работающий в режиме инжекции носителей заряда в область запиорного слоя и предназначенный для генерации сверхвысокочастотных колебаний</p>
<p>79. Переключательный диод</p> <p>D. Halbleiterschaltodiode</p> <p>E. Switching diode</p> <p>F. Diode de commutation</p>	<p>Полупроводниковый диод, имеющий на частоте сигнала низкое сопротивление при прямом смещении и высокое сопротивление — при обратном, предназ-</p>

Термин	Определение
<p>80. Смесительный диод D. Halbleitermischdiode E. Semiconductor mixer diode F. Diode mélangeuse</p>	<p>наченный для управления уровнем мощности сигнала Полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования высокочастотных сигналов в сигнал промежуточной частоты</p>
<p>81. Диод Ганна D. Gunn-Element E. Gunn diode F. Diode Gunn</p>	<p>Полупроводниковый диод, действие которого основано на появлении отрицательного объемного сопротивления под воздействием сильного электрического поля, предназначенный для генерации и усиления сверхвысокочастотных колебаний</p>
<p>82. Коммутационный полупроводниковый диод Коммутационный диод D. Halbleiter- HF-Schaltodiode</p>	<p>Полупроводниковый диод, предназначенный для коммутации высокочастотных цепей</p>
<p>83. Регулируемый резистивный диод D. PIN-Diode E. PIN diode F. Diode PIN</p>	<p>Полупроводниковый <i>p-i-n</i> диод, применяемый для регулирования сопротивления в тракте передачи сигнала, активное сопротивление которого для высокочастотного сигнала определяется постоянным током прямого смещения</p>
<p>84. Детекторный полупроводниковый диод Детекторный диод D. Halbleiterdemodulatordiode E. Detector diode F. Diode détectrice à semiconducteurs</p>	<p>Полупроводниковый диод, предназначенный для детектирования сигнала</p>
<p>85. Ограничительный полупроводниковый диод Ограничительный диод D. Halbleiterbegrenzerdiode E. Microwave limiting diode F. Diode de limitation de hyperfréquences</p>	<p>Полупроводниковый диод с лавинным пробоем, предназначенный для ограничения импульсов напряжения</p>
<p>86. Умножительный диод D. Halbleitervielfacherdiode E. Semiconductor frequency multiplication diode F. Diode pour multiplication de fréquence</p>	<p>Полупроводниковый диод, предназначенный для умножения частоты</p>
<p>87. Модуляторный диод D. Halbleitermodulatordiode E. Semiconductor modulator diode F. Diode modulatrice (à semiconducteurs)</p>	<p>Полупроводниковый диод, предназначенный для модуляции высокочастотного сигнала</p>
<p>88. Диод Шоттки D. Schottky-Diode F. Schottky (-barrier) diode F. Diode de Schottky</p>	<p>Полупроводниковый диод, выпрямительные свойства которого основаны на взаимодействии металла и обедненного слоя полупроводника</p>

Термин	Определение
<p>89. Варикап D. Kapazitätsdiode E. Variable capacitance diode F. Diode à capacité variable (varicape)</p>	<p>Полупроводниковый диод, действие которого основано на использовании зависимости емкости от обратного напряжения и который предназначен для применения в качестве элемента с электрически управляемой емкостью</p>
<p>90. Параметрический полупроводниковый диод Параметрический диод D. Halbleitervaraktorodiode E. Semiconductor parametric (amplifier) diode F. Diode paramétrique (à semi-conducteurs)</p>	<p>Варикап, предназначенный для применения в диапазоне сверхвысоких частот в параметрических усилителях</p>
<p>91. Полупроводниковый стабилизатор Стабилизатор Нид. <i>Зенеровский диод</i> D. Halbleiter-Z-Diode E. Voltage reference diode F. Diode de tension de référence</p>	<p>Полупроводниковый диод, напряжение на котором сохраняется с определенной точностью при протекании через него тока в заданном диапазоне, и предназначенный для стабилизации напряжения</p>
<p>92. (Исключен, Изм. № 2).</p>	
<p>93. Полупроводниковый шумовой диод D. Halbleiterrauschdiode E. Semiconductor noise diode F. Diode de bruit</p>	<p>Полупроводниковый прибор, являющийся источником шума с заданной спектральной плотностью в определенном диапазоне частот</p>
<p>94. Биполярный транзистор Транзистор D. Bipolarer Transistor E. Bipolar transistor F. Transistor bipolaire</p>	<p>Полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими переходами и тремя или более выводами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда.</p>
<p>95. Бездрейфовый транзистор Нид. <i>Диффузионный транзистор</i> D. Diffusionstransistor E. Diffusion transistor F. Transistor à diffusion</p>	<p>Примечание. Работа биполярного транзистора зависит от носителей обеих полярностей</p>
<p>96. Дрейфовый транзистор D. Drifttransistor E. Drift (diffused) transistor F. Transistor en dérive</p>	<p>Биполярный транзистор, в котором перенос неосновных носителей заряда через базовую область осуществляется в основном посредством диффузии</p>
<p>97. Точечный транзистор Нид. <i>Точечно-контактный диод</i> D. Spitzen transistor E. Point contact transistor F. Transistor à pointe</p>	<p>Биполярный транзистор, в котором перенос неосновных носителей заряда через базовую область осуществляется в основном посредством дрейфа</p>
<p>98. Точечный транзистор Нид. <i>Точечно-контактный диод</i> D. Spitzen transistor E. Point contact transistor F. Transistor à pointe</p>	<p>Биполярный транзистор с точечными переходами</p>

Термин	Определение
<p>98. Плоскостной транзистор D. Flächentransistor E. Junction transistor F. Transistor à jonction</p>	<p>Биполярный транзистор с плоскостными переходами</p>
<p>99. Лавинный транзистор D. Lawinentransistor E. Avalanche transistor F. Transistor à avalanche</p>	<p>Биполярный транзистор, действие которого основано на использовании режима лавинного размножения носителей заряда в коллекторном переходе</p>
<p>100. Полевой транзистор Надп. Канальный транзистор D. Feldeffekttransistor (FET) E. Field-effect transistor F. Transistor à effet de champ</p>	<p>Полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим через проводящий канал и управляемый электрическим полем.</p>
<p>101. Полевой транзистор с изолированным затвором D. Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate E. Insulated-gate FET F. Transistor à effet de champ à grille isolée</p>	<p>Примечание. Действие полевого транзистора обусловлено носителями заряда одной полярности Полевой транзистор, имеющий один или несколько затворов, электрически изолированных от проводящего канала</p>
<p>102. Полевой транзистор типа металл—диэлектрик—полупроводник МДП-транзистор D. MIS-Feldeffekttransistor (MIS-FET) E. MIS-transistor F. Transistor-MIS</p>	<p>Полевой транзистор с изолированным затвором, в котором в качестве изоляционного слоя между каждым металлическим затвором и проводящим каналом используется диэлектрик</p>
<p>103. Полевой транзистор типа металл—оксид—полупроводник МОП-транзистор D. MOS-Feldeffekttransistor (MOS-FET) E. MOS-transistor F. Transistor-MOS</p>	<p>Полевой транзистор с изолированным затвором, в котором в качестве изоляционного слоя между каждым металлическим затвором и проводящим каналом используется оксид</p>
<p>104. Симметричный транзистор D. Bidirektionaltransistor E. Bi-directional transistor F. Transistor bi-directionnel</p>	<p>Биполярный или полевой транзистор, сокращающий свои электрические характеристики при взаимной замене в схеме включения выводов эмиттера или источника и коллектора или стока</p>
<p>105. Тиристор D. Thyristor E. Thyristor F. Thyristor</p>	<p>Полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или более перехода, который может переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот</p>
<p>106. Дiodный тиристор Динистор D. Thyristordiode E. Diode thyristor E. Thyristor diode</p>	<p>Тиристор, имеющий два вывода</p>

Термин	Определение
<p>107. Днодный тиристор, не проводящий в обратном направлении</p> <p>D. Rückwärts sperrende Thyristordiode</p> <p>E. Reverse blocking diode thyristor</p> <p>F. Thyristor diode bloqué en inverse</p>	<p>Днодный тиристор, который при обратном напряжении не переключается, а находится в обратном непроводящем состоянии</p>
<p>108. Днодный тиристор, проводящий в обратном направлении</p> <p>D. Rückwärts leitende Thyristordiode</p> <p>E. Reverse conducting diode thyristor</p> <p>F. Thyristor diode passant en inverse</p>	<p>Днодный тиристор, который при обратном напряжении не переключается, а проводит большие токи при напряжениях, сравнимых по значению с прямым напряжением в открытом состоянии</p>
<p>109. Симметричный днодный тиристор</p> <p>Днак</p> <p>D. Zweirichtungsthyristordiode</p> <p>E. Bi-directional diode thyristor</p> <p>F. Thyristor diode bi-directionnel</p>	<p>Днодный тиристор, способный переключаться как в прямом, так и в обратном направлениях</p>
<p>110. Триодный тиристор</p> <p>Тринистор</p> <p>D. Thyristordiode</p> <p>E. Triode thyristor</p> <p>F. Thyristor triode</p>	<p>Тиристор, имеющий три вывода</p>
<p>111. Триодный тиристор, не проводящий в обратном направлении</p> <p>D. Rückwärts sperrende Thyristortriode</p> <p>E. Reverse blocking triode thyristor</p> <p>F. Thyristor triode bloqué en inverse</p>	<p>Триодный тиристор, который при обратном напряжении не переключается, а находится в обратном непроводящем состоянии.</p> <p>Примечание. Для триодных тиристоров, не проводящих в обратном направлении, допускается применять термин «тиристор», если исключается возможность другого толкования</p>
<p>112. Триодный тиристор, проводящий в обратном направлении</p> <p>D. Rückwärts leitende Thyristortriode</p> <p>E. Reverse conducting triode thyristor</p> <p>F. Thyristor triode passant en inverse</p>	<p>Триодный тиристор, который при обратном напряжении не переключается, а проводит большие токи при напряжениях, сравнимых по значению с прямым напряжением в открытом состоянии</p>

Термин	Определение
<p>113. Симметричный триодный тиристор</p> <p>Триак</p> <p>D. Zweirichtungsthyristortriode</p> <p>E. Bi-directional triode thyristor; Triac</p> <p>F. Thyristor triode bi-directionnel</p>	<p>Триодный тиристор, который при подаче сигнала на его управляющий вывод включается как в прямом, так и в обратном направлениях</p>
<p>114. Запираемый тиристор</p> <p>D. Abschaltbarer Thyristor</p> <p>E. Turn-off thyristor</p> <p>F. Thyristor blocable</p>	<p>Тиристор, который может быть переключен из открытого состояния в закрытое и наоборот путем подачи на управляющий вывод управляющих сигналов соответствующей полярности.</p> <p>Примечание. Отношение мощности управления к переключаемой мощности должно быть значительно меньше единицы</p>
<p>115. (Исключен, Изм. № 2).</p>	
<p>116. Тиристор с инжектирующим управляющим электродом р-типа</p> <p>D. Katodenseitig gesteuerter Thyristor</p> <p>E. P-gate thyristor</p> <p>F. Thyristor P</p>	<p>Тиристор, у которого управляющий электрод соединен с р-областью, ближайшей к катоду, который переводится в открытое состояние путем подачи на управляющий вывод положительного по отношению к катоду сигнала</p>
<p>117. Тиристор с инжектирующим управляющим электродом n-типа</p> <p>D. Anodenseitig gesteuerter Thyristor</p> <p>E. N-gate thyristor</p> <p>F. Thyristor N</p>	<p>Тиристор, у которого управляющий электрод соединен с n-областью, ближайшей к аноду, который переводится в открытое состояние при подаче на управляющий вывод отрицательного по отношению к аноду сигнала</p>
<p>117а. Лавинный триодный тиристор, непроводящий в обратном направлении</p> <p>Лавинный тиристор</p> <p>E. Avalanche reverse blocking thyristor</p>	<p>Тиристор с заданными характеристиками в точке минимального напряжения пробоя, предназначенный для рассеивания в течение ограниченной длительности импульса мощности в области пробоя вольт-амперной характеристики обратного непроводящего состояния</p>
<p>117б. Комбинированно-выключаемый тиристор</p>	<p>Тиристор, выключаемый с помощью тока управления при одновременном воздействии обратного анодного напряжения</p>
<p>118. Импульсный тиристор</p> <p>E. Pulse thyristor</p> <p>F. Thyristor signal</p>	<p>Тиристор, имеющий малую длительность переходных процессов и предназначенный для применения в импульсных режимах работы</p>
<p>119. Оптоэлектронный полупроводниковый прибор</p> <p>D. Optoelektronisches Halbleiterbauelement</p> <p>E. Semiconductor optoelectronic device</p>	<p>Полупроводниковый прибор, излучающий или преобразующий электромагнитное излучение или чувствительный к этому излучению в видимой, инфракрасной и (или) ультрафиолетовой областях спектра, или использующий подобное из-</p>

Термин	Определение
F. Dispositif optoelectronique semiconducteur 120. Полупроводниковый излучатель D. Halbleiterstrahler E. Semiconductor photoemitter F. Photoémetteur à semiconduc- teurs	лученные для внутреннего взаимодействия его элементов Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, преобразующий электрическую энергию в энергию электромагнитного излучения
120а. Полупроводниковый знако- синтезирующий индикатор E. Semiconductor character dis- play	По ГОСТ 25066—81
121. Оптопара D. Optoelektronischer Koppler E. Photocoupler; Optocoupler F. Photocoupleur	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучающего и фотоприемного элементов, между кото- рыми имеется оптическая связь и обе- спечена электрическая изоляция
121а. Резисторная оптопара	Оптопара с фотоприемным элементом, выполненным на основе фоторезистора
121б. Дiodная оптопара	Оптопара с фотоприемным элементом, выполненным на основе фотодиода
121в. Транзисторная оптопара	Оптопара с фотоприемным элементом, выполненным на основе фототранзисто- ра
121г. Тиристорная оптопара	Оптопара с фотоприемным элементом, выполненным на основе фототиристора
121д. (Исключен, Изм. № 3).	—
121е. Полупроводниковый излуча- тель, работающий с физическим при- емником	—
121а—121е. (Введены дополнительно,	Изм. № 1).
122. Светонизлучающий диод СИД D. Lichtemitterdiode (LED) E. Light-emitting diode (LED)	Полупроводниковый диод, излучающий энергию в видимой области спектра в результате рекомбинации электронов и дырок
123, 123а. (Исключены, Изм. № 2).	—
124. (Исключен, Изм. № 1).	—
125. (Исключен, Изм. № 2).	—
126. Полупроводниковый экран E. Semiconductor analog indi- cator	Полупроводниковый прибор, состоя- щий из светонизлучающих диодов, рас- положенных вдоль одной линии и со- держащих л строк светонизлучающих диодов, предназначенный для использо- вания в устройствах отображения ана- логовой и цифровой информации
127. Инфракрасный излучающий ди- од	Полупроводниковый диод, излучающий энергию в инфракрасной области спек- тра в результате рекомбинация электро- нов и дырок
И-К диод D. Infrarotemitterdiode (IRED) E. Infra-red-emitting diode F. Diode émettrice en infra- rouge	—

Термины	Определение
Элементы конструкции	
<p>128. Вывод полупроводникового прибора Вывод D. Anschluss eines Halbleiterbauelementes E. Terminal (of a semiconductor device) F. Borne</p>	<p>Элемент конструкции корпуса полупроводникового прибора, необходимый для соединения соответствующего электрода с внешней электрической цепью.</p>
<p>129. Основной вывод полупроводникового прибора D. Basisanschluss eines Halbleiterbauelementes E. Main terminal F. Borne principale</p>	<p>Вывод полупроводникового прибора через который протекает основной ток</p>
<p>130. Катодный вывод полупроводникового прибора D. Katodenschluss eines Halbleiterbauelementes E. Cathode terminal (of a semiconductor device) F. Cathode</p>	<p>Вывод полупроводникового прибора, от которого прямой ток течет во внешнюю электрическую цепь</p>
<p>131. Анодный вывод полупроводникового прибора D. Anodenanschluss eines Halbleiterbauelementes E. Anode terminal (of a semiconductor device) F. Anode</p>	<p>Вывод полупроводникового прибора, к которому прямой ток течет из внешней электрической цепи</p>
<p>132. Управляющий вывод полупроводникового прибора E. Gate terminal (of a semiconductor device) F. Grille</p>	<p>Вывод полупроводникового прибора через который течет только ток управления</p>
<p>133. Корпус полупроводникового прибора Корпус D. Gehäuse eines Halbleiterbauelementes E. Package (case) (of a semiconductor device) F. Capsule</p>	<p>Часть конструкции полупроводникового прибора, предназначенная для защиты от воздействия окружающей среды, а также для присоединения прибора к внешним схемам с помощью выводов</p>
<p>134. Бескорпусный полупроводниковый прибор Ндв. <i>Полупроводниковая структура</i> D. Gehäuseloses Halbleiterbauelement E. Beam lead semiconductor device F. Dispositif semiconducteur sans boitier</p>	<p>Полупроводниковый прибор, не защищенный корпусом и предназначенный для использования в гибридных интегральных микросхемах, герметизируемых блоках и аппаратуре</p>

Термин	Определение
135. Полупроводниковый излучающий элемент	Часть полупроводникового прибора отображения информации, состоящая из излучающей поверхности и контактов для подключения к электрической схеме
135а. Электрод полупроводникового прибора E. Electrode (of a semiconductor device)	Часть полупроводникового прибора, обеспечивающая электрический контакт между определенной областью полупроводникового прибора и выводом

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

База	26
Блок выпрямительный	71
Блок полупроводниковый	64
Блок полупроводниковый выпрямительный	71
Варикан	89
<i>Вентиль полупроводниковый</i>	66
Включение тиристора	60
Восстановление полупроводникового диода обратное	55
Восстановление полупроводникового диода прямое	54
Вывод	128
Вывод полупроводникового прибора	129
Вывод полупроводникового прибора анодный	131
Вывод полупроводникового прибора катодный	130
Вывод полупроводникового прибора основной	129
Вывод полупроводникового прибора управляющий	132
Выключение тиристора	61
Гетеропереход	16
Гомопереход	17
Диак	109
Диактор	106
Диод	66
Диод выпрямительный	69
Диод выпрямительный лавинный	69а
Диод Ганна	81
Диод детекторный	84
<i>Диод Зенеровский</i>	91
Диод излучающий инфракрасный	127
Диод импульсный	72
Диод инжекционно-пролетный	78
Диод коммутационный	82
Диод лавинно-пролетный	77
Диод модуляторный	87
Диод обращенный	75
Диод ограничительный	85
Диод параметрический	90
Диод переключательный	79
Диод плоскостной	68
Диод полупроводниковый	66

Диод полупроводниковый выпрямительный	69
Диод полупроводниковый детекторный	84
Диод полупроводниковый импульсный	72
Диод полупроводниковый коммутационный	82
Диод полупроводниковый ограничительный	85
Диод полупроводниковый параметрический	90
Диод полупроводниковый сверхвысокочастотный	76
Диод резистивный регулируемый	83
Диод светонизлучающий	122
Диод смесительный	80
Диод с накоплением заряда	73
Диод с контролируемым лавинным пробоем полупроводниковый выпрямительный	606
Диод точечно-контактный	67
Диод точечный	67
Диод туннельный	74
Диод умножительный	86
Диод Шоттки	68
Диод шумовой полупроводниковый	93
Затвор	33
Излучатель полупроводниковый	120
Излучатель, работающий с физическим приемником, полупроводниковый	121e
И-К диод	127
Индикатор знаковинтезирующий полупроводниковый	120a
Исток	32
Канал проводящий	31
Коллектор	28
Контакт линейный	20
Корпус	133
Корпус полупроводникового прибора	133
МДП-транзистор	102
Мезоструктура	38
Модуляция толщины базы	50
МОП-транзистор	103
Набор полупроводниковых приборов	65
Накопление заряда в базе	52
Накопление неравновесных носителей заряда в базе	52
Направление для $p-n$ перехода обратное	44
Направление для $p-n$ перехода прямое	43
Область базовая	26
Область дырочная	23
Область коллекторная	28
Область собственной электропроводности	25
Область собственная	25
Область электронная	24
Область эмиттерная	27
Область i	25
Область n	24
Область p	23
Оптопара	121
Оптопара диодная	121
Оптопара резисторная	121a
Оптопара тиристорная	121b
Оптопара транзисторная	121a
Переключение тиристора	59
Переход	1
Переход впаивкой	12

Переход выпрямляющий	19
Переход выращенный	14
Переход гетерогенный	16
Переход гомогенный	17
Переход диффузионный	9
Переход дырочно-дырочный	4
Переход коллекторный	22
Переход конверсионный	11
<i>Переход микровсплавной</i>	13
Переход микросплавной	13
Переход омический	20
Переход плавный	6
Переход плазменный	10
Переход плоскостной	7
Переход резкий	5
Переход сплавной	12
Переход точечный	8
<i>Переход тянутый</i>	14
Переход Шоттки	18
Переход электрический	1
Переход электронно-дырочный	2
Переход электронно-электронный	3
Переход эмиттерный	21
Переход эпитаксиальный	15
Переход $n-p^+$	3
Переход $p-n$	2
Переход $p-p^+$	4
Прибор полупроводниковый (ПП)	62
Прибор полупроводниковый бескорпусный	131
Прибор полупроводниковый оптоэлектронный	119
Прибор полупроводниковый силовой (СПП)	63
Пробой $p-n$ перехода	45
Пробой $p-n$ перехода лавинный	47
Пробой $p-n$ перехода тепловой	49
Пробой $p-n$ перехода туннельный	48
Пробой $p-n$ перехода электрический	46
<i>Прокос базы</i>	51
Рассеивание заряда в базе	53
Рассеивание неравновесных носителей заряда в базе	53
СВЧ-диод	76
СИД	122
Слой запирающий	40
<i>Слой затормозный</i>	40
Слой инверсный	42
Слой обедненный	39
Слой обогащенный	41
Состояние тиристора в обратном направлении непереводящее	58
Состояние тиристора закрытое	56
Состояние тиристора открытое	57
Стабилитрон	91
Стабилитрон полупроводниковый	91
Столб выпрямительный	70
Столб полупроводниковый выпрямительный	70
Сток	33
Структура	35
Структура МДП	36
Структура металл—диэлектрик—полупроводник	36

Структура металл—окисел—полупроводник	37
Структура МОП	37
Структура полупроводниковая	134
Структура полупроводникового прибора	35
Тиристор	105
Тиристор диодный	106
Тиристор диодный симметричный	109
Тиристор запираемый	114
Тиристор импульсный	118
Тиристор комбинированно-выключаемый	117б
Тиристор лавинный	117а
Тиристор, непроводящий в обратном направлении, диодный	107
Тиристор, непроводящий в обратном направлении, триодный	111
Тиристор, проводящий в обратном направлении, диодный	108
Тиристор, проводящий в обратном направлении, триодный	112
Тиристор, непроводящий в обратном направлении, триодный лавинный	117а
Тиристор с инжектирующим управляющим электродом р-типа	116
Тиристор с инжектирующим управляющим электродом n-типа	117
Тиристор триодный	110
Тиристор триодный симметричный	113
Транзистор	94
Транзистор бездрейфовый	96
Транзистор биполярный	94
Транзистор диффузионный	95
Транзистор дрейфовый	96
Транзистор канальный	100
Транзистор лавинный	99
Транзистор типа металл—окисел—полупроводник полевой	103
Транзистор плоскостной	98
Транзистор полевой	100
Транзистор с изолированным затвором полевой	101
Транзистор симметричный	104
Транзистор типа металл—диэлектрик—полупроводник полевой	102
Триод точечно-контактный	97
Транзистор точечный	97
Триак	113
Тринистор	110
Часть базовой области активная	29
Часть базовой области пассивная	30
Элемент излучающий полупроводниковый	135
Электрод полупроводникового прибора	135а
Эмиттер	27
Эффект смыкания	51

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abbau von Überschussladungsträgern in der Basis	53
Abschaltbarer Thyristor	114
Aktiver Teil des Basisgebietes eines bipolaren Transistors	29
Anodenanschluss eines Halbleiterbauelementes	131
Anodenseitig gesteuerter Thyristor	117
Anreicherungsschicht	41
Ausschluss eines Halbleiterbauelementes	128
Ausschalten eines Thyristors	61
Basisanschluss eines Halbleiterbauelementes	129

Basisgebiet	26
Bidirektionaltransistor	104
Bipolarer Transistor	94
Blockierzustand eines Thyristors	56
Defektelektronengebiet	23
Diffundierter Übergang	9
Diffusionstransistor	96
Drain (Senke)	33
Drifttransistor	96
Durchbruch des pn-Überganges	45
Durchgreifeffekt	51
Durchlassrichtung des pn-Überganges	43
Durchlasszustand eines Thyristors	57
Eigenleitungsgebiet	25
Einschwingen des Durchlasswiderstandes einer Halbleiterdiode	54
Elektrischer Durchbruch des pn-Überganges	46
Elektrischer Übergang (Sperrschicht)	1
Elektronengebiet	24
Emittiergebiet	27
Emitterübergang	21
Epitaxieübergang	15
Gate (Tor)	34
Gehäuse eines Halbleiterbauelementes	123
Gehäuseloses Halbleiterbauelement	134
Gezogener Übergang	14
Gleichrichterübergang	19
Gunn-Element	81
Feldeffekttransistor (FET)	100
Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate	101
Flächentransistor	98
Flächenübergang	7
Halbleiterbauelement	62
Halbleiterbegrenzerdiode	85
Halbleiterdemodulatordiode	84
Halbleiterdiode	66
Halbleiterfrächendiode	68
Halbleitergleichrichterdiode	69
Halbleiter-HF-Schaltodiode	82
Halbleiterimpulsdiode	72
Halbleiterinjektionslaufzeitdiode	78
Halbleiterlawinenlaufzeitdiode	77
Halbleiterleistungsbauelement	63
Halbleitermischdiode	90
Halbleitermodulatordiode	87
Halbleiterrauschdiode	93
Halbleiterschaltodiode	79
Halbleiterspitzendiode	67
Halbleiterstrahler	120
Halbleitertunneldiode	74
Halbleiterunttunneldiode	75
Halbleitervaraktoridiode	90
Halbleitervervielfacherdiode	86
Halbleiter-Z-Diode	91
Heteroübergang	16
Homogener Übergang	17
Infrarotemitterdiode (IRED)	127
Inversionsschicht	42
Kanal	31

Капацитэсдиоде	89
Катоденаншлус еинес Халблеитербауелементес	130
Катоденсеитиг гестеуертер Тхыристор	116
Коллекторгебит	28
Коллекторуберганг	22
Конверсионсуберганг	11
Ладунгссpeicherдиоде	73
Лавинендурчbruch дес pn-Убергангес	47
Лавинентрансисстор	99
Легииртер Уберганг	12
Личтемиттердиоде (LED)	122
Месаструктур	38
Металл-Диелектрикум-Халблеитер-Структур (MIS-Структур)	36
Металл-Оксид-Халблеитер-Структур (MOS-Структур)	37
Микролегииртер Уберганг	13
MIS-Фелдеффекттрансисстор (MIS-FET)	192
Модулатион дер Базисбреитте	30
MOS-Фелдеффекттрансисстор (MOS-FET)	103
nn ⁺ -Уберганг	3
Омисчер Уберганг	20
Оптоелектронисчер Копплир	121
Оптоелектронисчер Халблеитербауелемент	119
Пассивер Teil дес Базисгебитес еинес биполарен Трансиссторс	30
PIN-Диоде	83
Планаруберганг	10
pn-Уберганг	2
pp ⁺ -Уберганг	4
Пунктуберганг	8
Рукквартс лейтенде Тхыристордиоде	108
Рукквартс лейтенде Тхыристортиоде	112
Рукквартс сперренде Тхыристордиоде	107
Рукквартс сперренде Тхыристортиоде	111
Схоттки-Диоде	88
Схоттки-Уберганг	18
Source (Quelle)	32
Спечерунг вон Уберсхуссладунгстрэгери в дер Базис	32
Сперирихунг дес pn-Убергангес	14
Сперирихшихт	40
Сперирихзустанд еинес Тхыристорс	38
Спитзентрансисстор	97
Стеилер Уберганг	5
Стеилер Уберганг	6
Стеуерелектроде еинес Халблеитербауелементес	132
Структур еинес Халблеитербауелементес	35
Термисчер Дурчbruch дес pn-Убергангес	49
Тхыристор	105
Тхыристордиоде	106
Тхыристортиоде	110
Туннелдурчbruch дес pn-Убергангес	48
UHF-Халблеитердиоде	78
Умсхалтен еинес Тхыристорс	59
Верармунгсшихт	39
Видерхерстеллунг дес Сперирихвирстендес еинер Халблеитердиоде	55
Зунден еинес Тхыристорс	60
Звейрихтунгс-Тхыристордиоде	109
Звейрихтунгс-Тхыристортиоде	113

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abrupt junction	5
Active part of base region	29
Alloyed junction	12
Anode terminal (of a semiconductor device)	131
Avalanche rectifier diode	69a
Avalanche reverse blocking thyristor	117a
Avalanche transistor	99
Barrier region (layer)	40
Base region	26
Base thickness modulation	50
Beam lead semiconductor device	134
Bi-directional diode thyristor	109
Bi-directional transistor	104
Bi-directional triode thyristor	113
Bipolar transistor	94
Breakdown of a P-N junction	45
Cathode terminal (of a semiconductor device)	130
Channel	31
Collector junction	22
Collector region	28
Controlled-avalanche rectifier diode	69b
Conversion junction	11
Depletion layer	39
Detector diode	84
Diffused junction	9
Diffusion transistor	95
Diode thyristor	106
Drain	33
Drift (diffused) transistor	96
Electrode (of a semiconductor device)	135a
Emitter junction	21
Emitter region	27
Enriched layer	41
Epitaxial junction	15
Excess carrier reabsorption (in the base)	53
Field-effect transistor	100
Forward direction (of a P-N junction)	43
Forward recovery	54
Gate	34
Gate terminal (of a semiconductor device)	132
Gate triggering of a thyristor	60
Gate turning-off of a thyristor	61
Graded junction	6
Grown junction	14
Gunn diode	81
Heterogenous junction	16
Homogenous junction	17
Impact avalanche-(and-) transit time diode	77
Infra-red-emitting diode	127
Injection-(and-) transit time diode	78
Insulated-gate FET	101
Intrinsic region	25
Inversion layer	42
Junction	1
Junction diode	68

Junction transistor	98
Light-emitting diode (LED)	122
Main terminal	129
Mesa-structure	38
Micro-alloy junction	13
Microwave diode	76
Microwave limiting diode	85
Minority carrier storage (in the base)	52
MIS-structure	36
MIS-transistor	102
MOS-structure	37
MOS-transistor	103
N-gate thyristor	117
N-N ⁺ junction	3
N-region	24
Off-state of a thyristor	56
Ohmic junction	20
On-state of a thyristor	57
Optocoupler	121
Package (case) (of a semiconductor device)	133
Passive part of base region	30
P-gate thyristor	116
Photocoupler	121
PIN diode	83
Planar junction	10
P-N junction	2
(P-N junction) avalanche breakdown	47
P-N junction electrical breakdown	46
(P-N junction) thermal breakdown	49
Point contact diode	67
Point-contact junction	8
Point-contact transistor	97
P-P ⁺ junction	4
P-region	23
Pulse thyristor	119
Punch-through	51
Rectifying junction	19
Reverse blocking diode thyristor	107
Reverse blocking state of a thyristor	58
Reverse blocking triode thyristor	111
Reverse conducting diode thyristor	108
Reverse conducting triode thyristor	112
Reverse direction (of a P-N junction)	44
Reverse recovery	55
Schottky (-barrier) diode	88
Schottky junction	18
Semiconductor analog indicator	126
Semiconductor assembly	64
Semiconductor assembly set	65
Semiconductor character display	120a
Semiconductor device	52
Semiconductor diode	66
Semiconductor frequency multiplication diode	86
Semiconductor mixer diode	80
Semiconductor modulator diode	87
Semiconductor noise diode	93
Semiconductor optoelectronic device	119

Semiconductor optoelectronic display	126
Semiconductor parametric (amplifier) diode	90
Semiconductor photoemitter	120
Semiconductor power device	63
Semiconductor rectifier assembly	71
Semiconductor rectifier diode	69
Semiconductor rectifier stack	70
Signal diode	72
Snap-off (step-recovery) diode	73
Source	32
Structure	35
Surface junction	7
Switching diode	79
Switching of a thyristor	69
Terminal (of a semiconductor device)	128
Thyristor	105
Triac	113
Triode thyristor	110
Tunnel diode	74
Turn-off thyristor	114
Unitunnel (backward) diode	75
Variable capacitance diode	89
Voltage reference diode	91
Zenner (tunnel) breakdown	48

(Измененная редакция, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Accumulation de porteurs d'excès dans la base	52
Amorçage de thyristor	60
Anode	131
Assemblage à semiconducteurs	64
Assemblage de redressement (à semiconducteurs)	71
Bloc de redressement (à semiconducteurs)	70
Borne	128
Borne principale	129
Canal	31
Capsule	133
Cathode	130
Claquage (d'une jonction P-N)	45
Claquage électrique (d'une jonction P-N)	46
Claquage par avalanche (d'une jonction P-N)	47
Claquage par effet thermique (d'une jonction P-N)	49
Claquage par effet Zenner (tunnel)	48
Commutation de thyristor	59
Couche de déplétion	39
Couche d'inversion	42
Couche enrichie	41
Désamorçage de thyristor	61
Diode à avalanche à temps de transit	77
Diode à capacité variable (varicape)	89
Diode à injection à temps de transit	78
Diode à jonction	68
Diode à pointe	67
Diode à semiconducteurs	66
Diode à semiconducteurs pour forte puissance	63

Diode de bruit	93
Diode de commutation	79
Diode de limitation de hyperfréquences	85
Diode de redressement	69
Diode de Schottky	88
Diode délectrice à semiconducteurs	94
Diode de tension de référence	91
Diode d'impulsion	72
Diode émettrice en infrarouge	127
Diode en hyperfréquences	76
Diode Gunn	81
Diode inversé	75
Diode mélangeuse	80
Diode modulatrice (à semiconducteurs)	87
Diode paramétrique (à semiconducteurs)	90
Diode PIN	83
Diode pour multiplication de fréquence	86
Diode tunnel	74
Dispositif optoélectronique semiconducteur	119
Dispositif à semiconducteurs	62
Dispositif semiconducteur sans boîtier	134
Drain	33
Etat bloqué dans le sens inverse de thyristor	58
Etat bloqué de thyristor	56
Etat passant de thyristor	57
Grille	34, 132
Jonction	1
Jonction abrupte	5
Jonction à diffusion	9
Jonction allié	12
Jonction à pointe	8
Jonction collecteur	22
Jonction de conversion	11
Jonction de croissance	14
Jonction de par surface	7
Jonction émetteur	21
Jonction épitaxiale	15
Jonction graduelle	6
Jonction hétérogène	16
Jonction homogène	17
Jonction microallié	13
Jonction N-N	3
Jonction ohmique	20
Jonction planar	10
Jonction P-N	2
Jonction P-P	4
Jonction redresseuse	19
Jonction Schottky	18
Modulation d'épaisseur de base	50
Pénétration	51
Photocoupler	121
Photoémetteur à semiconducteurs	120
Recouvrement direct	54
Recouvrement inverse	55
Région active de base	29
Région de barrière	40
Région de base	26

Région de collecteur	28
Région d'émetteur	27
Région intrinsèque	25
Région N	24
Région P	23
Région passive de base	30
Résorption de porteurs d'excès dans la base	53
Sens direct (d'une jonction P-N)	43
Sens inverse (d'une jonction PN)	44
Source	32
Structure	35
Structure-mésa	38
Structure-MIS	36
Structure-MOS	57
Thyristor	105
Thyristor blocable	114
Thyristor diode	106
Thyristor diode bi-directionnel	109
Thyristor diode bloqué en inverse	107
Thyristor diode passant en inverse	108
Thyristor N	117
Thyristor P	116
Thyristor signal	118
Thyristor triode	110
Thyristor triode bi-directionnel	113
Thyristor triode bloqué en inverse	111
Thyristor triode passant en inverse	112
Transistor à avalanche	99
Transistor à diffusion	95
Transistor à effet de champ	100
Transistor à effet de champ à grille isolée	101
Transistor à jonction	98
Transistor à pointe	97
Transistor bi-directionnel	104
Transistor bipolaire	94
Transistor en dérivation	96
Transistor-MIS	102
Transistor-MOS	103

(Наименная редакция, Изм. № 2, 3).

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ СТ СЭВ 2767—85, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩИЙ
СТАНДАРТ**

1. Фоточувствительный полупроводниковый прибор.
2. Фотоэлектрический полупроводниковый приемник излучения.
3. Фоторезистор
4. Фотодиод
5. Фототранзистор
6. Фототиристор
7. Туннельный эффект

(Введено дополнительно, Изм. № 2, 3).

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 23.04.87 Подп. и печ. 08.06.87 2,0 усл. п. л. 2,0 усл. ир.-отт. 2,60 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауга, 12/14. Зак. 2270.

Изменение № 4 ГОСТ 15133—77 Приборы полупроводниковые. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.88 № 2193

Дата введения 01.12.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий полупроводниковых приборов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 2767—85 приведена в приложении.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

(Продолжение см. с. 368)

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Идн».

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E), и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—5.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Таблицу дополнить словом: «Таблица 1»;

(Продолжение см. с. 369)

графа «Термин». Термин 120 дополнить краткой формой: «Излучатель»;
 графа «Определение». Для термина 121 заменить слова: «излучающего и фотоприемного элементов» на «излучателя и приемника излучения»;
 для терминов 121а — 121г заменить слова: «фотоприемного элемента» на «приемником излучения».
 Стандарт дополнить терминами — 120б, 121ж, 121з, 127а— 127с и их определениями:

Термин	Определение
120б. Полупроводниковый приемник излучения оптоэлектронного прибора Приемник излучения	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, преобразующий энергию оптического излучения в электрическую энергию от полупроводникового излучателя и работающего в паре с ним
121ж. Дифференциальная диодная оптопара	Диодная оптопара, в которой два близких по определяющим параметрам фотодиода принимают световой поток от одного излучателя
121з. Тиристорная оптопара с симметричным выходом	Тиристорная оптопара, с симметричным диодным или триодным фототиристором
127а. Фотодиод D. Fotodiode E. Photodiode F. Photodiode	По ГОСТ 21934—83
127б. Фототранзистор D. Fototransistor E. Phototransistor F. Phototransistor	По ГОСТ 21934—83
127в. Фоторезистор D. Fotowiderstand E. Photoconductive cell F. Cellule photoinductive	По ГОСТ 21934—83
127г. Фототиристор D. Fotothiristor E. Photothyristor F. Photothyristof	Тиристор, в котором используется фотоэлектрический эффект
127д. Оптоэлектронный коммутатор аналогового сигнала	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучателя и приемника излучения со схемой коммутации аналогового сигнала на выходе
127е. Оптоэлектронный коммутатор нагрузки	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучателя и приемника излучения со схемой коммутации тока на выходе
127ж. Оптоэлектронный коммутатор постоянного тока	Оптоэлектронный коммутатор нагрузки со схемой коммутации по цепям постоянного тока
127з. Оптоэлектронный коммутатор переменного тока	Оптоэлектронный коммутатор нагрузки со схемой коммутации по цепям переменного тока
127и. Оптоэлектронный переключатель логических сигналов	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучателя и приемника излучения со схемой логического ключа на выходе

(Продолжение см. с. 370)

Термин	Определение
127к. Линейный оптоэлектронный полупроводниковый прибор	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из дифференциальной оптопары или двух диодных оптопар и предназначенный для преобразования сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции
127д. Окстрон	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, в котором оптическая связь между излучателем и приемником излучения осуществляется по открытому оптическому каналу
127м. Отражательный окстрон	Окстрон, в котором приемник излучения принимает световой поток, отраженный от отражательной поверхности, расположенной на определенном расстоянии от излучателя
127н. Щелевой окстрон	Окстрон, в котором между излучателем и приемником излучения для управления световым потоком устанавливается светопроницаемую заслонку
127о. Волстрон	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, в котором оптическая связь между излучателем и приемником излучения осуществляется по протяженному оптическому каналу.
	<i>Примечание.</i> Излучатель и приемник излучения могут иметь схемы электронного обрамления
127п. Оптопреобразователь	Оптоэлектронный полупроводниковый прибор с одним или несколькими р—п переходами, работающий в режиме передачи и (или) приема оптического излучения
127р. Линейка оптоэлектронных полупроводниковых приборов	Совокупность оптоэлектронных полупроводниковых приборов, расположенных с заданным шагом на одной линии
127с. Матрица оптоэлектронных полупроводниковых приборов	Совокупность оптоэлектронных полупроводниковых приборов, сгруппированных по строкам и столбцам

Алфавитный указатель терминов на русском языке изложить в виде таблицы 2 со следующей головкой:

Термин	Номер термина
--------	---------------

Таблицу дополнить терминами (в алфавитном порядке):

«Волстрон	127о
Излучатель	120
Коммутатор аналогового сигнала оптоэлектронный	127д
Коммутатор нагрузки оптоэлектронный	127е
Коммутатор переменного тока оптоэлектронный	127з

(Продолжение см. с. 371)

Термин	Номер термина
Коммутатор постоянного тока оптоэлектронный	127ж
Линейка оптоэлектронных полупроводниковых приборов	127р
Матрица оптоэлектронных полупроводниковых приборов	127с
Окстрон	127л
Окстрон отражательный	127м
Окстрон шелевой	127н
Оптопара диодная дифференциальная	121ж
Оптопара с симметричным выходом тиристорная	121з
Оптопреобразователь	127п
Переключатель логических сигналов оптоэлектронный	127и
Прибор полупроводниковый оптоэлектронный линейный	127к
Приемник излучения	120б
Приемник излучения оптоэлектронного прибора полупроводниковый	120б
Фотодиод	127а
Фоторезистор	127в
Фототиристор	127г
Фототранзистор	127б*

Алфавитный указатель терминов на немецком языке изложить в виде таблицы 3 со следующей головкой:

Термин	Номер термина
--------	---------------

Таблицу дополнить терминами (в алфавитном порядке):

«Fotodiode	127а
Fotothiristor	127г
Fototransistor	127б
Fotowiderstand	127в*

(Продолжение см. с. 372)

Алфавитный указатель терминов на английском языке изложить в виде таблицы 4 со следующей головкой:

Термин	Номер термина
--------	---------------

Таблицу дополнить терминами (в алфавитном порядке):

«Photoconductive cell	127в
Photodiode	127а
Photothyristor	127г
Phototransistor	127бэ.

Алфавитный указатель терминов на французском языке изложить в виде таблицы 5 со следующей головкой:

Термин	Номер термина
--------	---------------

Таблицу дополнить терминами (в алфавитном порядке):

«Cellule photoinductive	127в
Photodiode	127а
Photothyristor	127г
Phototransistor	127бэ..

Приложение изложить в новой редакции:

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ
ГОСТ 15133—77 СТ СЭВ 2767—85**

Номер пункта ГОСТ 15133—77	Номер пункта СТ СЭВ 2767—85
—	2.6
—	4.61
—	4.62

(ИУС № 10 1988 г.)